

## 化合物半導体用ドライエッチング装置「LETH-300」

概要・品質・性能

炭化シリコン（SiC）・窒化ガリウム（GaN）ダイヤモンド（C）などの化合物半導体基板のエッチングに適した反応室とロードロック室のエッチング装置。サイズは800（W）×800（D）×1800（H）、広帯域ターボ分子ポンプ、振り子式コントロール弁の採用に加え、チャンバの最小容積設計により高排気効率を実現。これによりガスのチャンバ内の平均滞留時間を大幅に削減し、高精度・高密度のプラズマを実現した。このICPプラズマによりSiCやサファイアなどの高速レートエッチングが可能のため、基板を高速・高精度で加工できる。

自動運転が可能で、20ステップまでレシピの作成ができ、なおかつ100レシピまでの登録が可能。希望小売価格 40,000千円

プラズマエッチング装置「LETH-300」



用途

(1) 化合物系ドライエッチング工程にて使用

技術移転

- (1) 形態 共同研究開発、製品供給  
 (2) 相手先 半導体製造業、太陽光発電関連  
 (3) 地域 国内に限る

実用化・情報

[試作・実験] 完了

[製造・販売実績] 有り

[技術情報の提供] パンフレット

[情報提供者] (株) ヒューズ・テクノネット

レスカ事業部営業技術2課 藤井 圭

[連絡先] (財)りそな中小企業振興財団 事務局  
 TEL.03-3444-9541 FAX.03-3444-9546

特許等